

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成16年11月18日(2004.11.18)

【公表番号】特表2000-513146(P2000-513146A)

【公表日】平成12年10月3日(2000.10.3)

【出願番号】特願平10-502903

【国際特許分類第7版】

H 01 S 5/347

【F I】

H 01 S 3/18 6 7 8

【手続補正書】

【提出日】平成16年1月16日(2004.1.16)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

手 続 補 正 書

平成16年1月16日

特許庁長官 今 井 康 夫 殿

1. 事件の表示

平成10年特許願第502903号

2. 補正をする者

名称 ミネソタ マイニング アンド マニュファクチャリング
 カンパニー (外1名)

3. 代 理 人

住所 〒105-8423 東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル
 青和特許法律事務所 電話 03-5470-1900

氏名 弁理士 (7751) 石 田 敬 

4. 補正対象書類名

請求の範囲

5. 補正対象項目名

請求の範囲

6. 補正の内容

請求の範囲を別紙の通り補正します。

7. 添付書類の目録

請求の範囲

1通



方 式 査
 審 (佐藤)

請求の範囲

1. B_e を含んだII-VI族半導体からなる第1の導電型を有する第1のクラッド層と、

前記第1のクラッド層の上に重なるII-VI族半導体からなる第1のガイド層と

前記第1のガイド層の上に重なるII-VI族半導体からなる活性層と、

前記活性層の上に重なるII-VI族半導体からなる第2のガイド層と、

前記第2のガイド層の上に重なる B_e を含んだII-VI族半導体からなる第2の導電型を有する第2のクラッド層と、

を含むII-VI族化合物半導体レーザダイオード。

2. 前記第1のクラッド層が $B_{e_x} Mg_y Z_{n_1-x-y} Se$ ($0 < x \leq 1$ 、及び、 $0 \leq y \leq 1$) を含んで成り、前記第2のクラッド層が $B_{e_x} Mg_y Z_{n_1-x-y} Se$ ($0 < x \leq 1$ 、及び、 $0 \leq y \leq 1$) を含んで成る請求項1に記載のII-VI族化合物半導体レーザダイオード。

3. 前記第1のガイド層が $B_{e_x} Z_{n_1-x} Se$ ($0 < x \leq 1$) を含んで成り、前記第2のガイド層が $B_{e_x} Z_{n_1-x} Se$ ($0 < x \leq 1$) を含んで成る請求項1または2に記載のII-VI族化合物半導体レーザダイオード。